

Panasonic

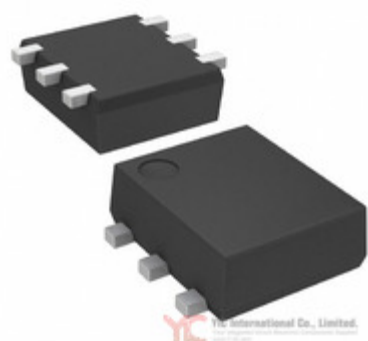


Image may be representation.
See specs for product details.

FJ6K01010L









Hersteller-Teilenummer:	FJ6K01010L
Hersteller / Marke:	Panasonic
Teil der Beschreibung:	MOSFET P-CH 12V 4A WSMINI6
Datenblätter:	FJ6K01010L.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 39000 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FJ6K01010L
Hersteller	Panasonic
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 4A WSMINI6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	39000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-SMD, Flat Leads
Supplier Device-Gehäuse	WSMini6-F1-B
Verlustleistung (max)	700mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	34 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1400pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FJ6K01010L ist neu im Original, Suche FJ6K01010L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FJ6K01010L Panasonic mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FJ6K01010L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>RJK6018DPM-00#T1 Renesas Electronics America MOSFET N-CH 600V 30A TO3PFM</p>	 <p>R6012ANJTL LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 10V DRIVE LPTS</p>	 <p>NTMFS4C054NT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 22.5A 80A 5DFN</p>	 <p>STW26NM60N STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 20A TO-247</p>
 <p>RJK6012DPE-00#J3 Renesas Electronics America MOSFET N-CH 600V 10A LDPK</p>	 <p>NDD60N360U1T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 114A DPAK</p>	 <p>APTC80SK15T1G Microsemi MOSFET N-CH 800V 28A SP1</p>	 <p>IRFZ46NLPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 53A TO-262</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ 1808GC101KAT1A	↔ 2MBI450VN-120-85	⇒ ACF321825-102-T	D AM29LV010B-70JK	⇒ AWL6951RM22
⊣ BA779-2-V-GH-08	⊛ BQ24382DSGR	D BTA204X-600B	⇒ DR36119KCC11BQC	⇒ DS2502P+T&R
⊛ ELM14613AA-N	⊣ FZ800R33KL2C_B5	⊛ GJM0225C1E130JB01L	↔ GRM1555C1H2R8WZ01D	⇒ GT10J101
D HI2220P271R-10	⊛ IRF7459TRPBF	⊣ ISL59440IAZ	⊛ ISL8120CRZ	⇒ IXTH26N60P
⇒ JAN1N3005B	↔ LM3480IM3-5.0	⊛ LM49743MT	⊣ LT1198CS8	⇒ LT1507CS8-3.3#TRPBF
↔ LTC1878EMS8#TRPBF	⇒ MAX1714BEEE	D MAX3095EPE	⊛ MC33470DWR2	⊣ MCC26-08IO8 B
⊛ MP4566DD-LF-Z	D NFM21PC104R1E3D	⇒ P2501NZB0	↔ P2H4M441L	⇒ PI5C3306LEX
⊣ SI-3010KM-TL	⊛ SKDH100/14	↔ SKKD105F12	⇒ SKN12/04	⇒ SN65LVDS301ZQER
⊛ SST39F020-45-4C-B3K	⊣ STS4NF100	⊛ SW08CXC27C	D TDA8722T	⇒ TM8205FC-C
↔ TPSD476K016R0150V	⊛ VE-J20-EX	⊣ VI-24Z-E	⊛ W25Q80BVSNI6	⇒ XC6210A502PR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited